METHOD FOR WORKING LIQUID CRYSTAL

Publication number: JP2074924

Publication date: 1990-03-14

Inventor:

HOSHINO HIROSHI

Applicant:

SANYO CHEMICAL IND LTD

Classification:

- international:

G02F1/13; G02B5/30; G02F1/1337; G02B5/30;

G02F1/13; (IPC1-7): G02F1/13; G02F1/1337

- European:

G02F1/1337C

Application number: JP19880228125 19880912 **Priority number(s):** JP19880228125 19880912

Report a data erro

Abstract of JP2074924

PURPOSE:To obtain an oriented film uniform over the entire part by crosslinking the liquid crystal which is I and oriented by a substrate subjected to a chemical or physical orientation treatment. CONSTITUTION:The crystal is supported and oriented by the substrate subjected to the orientation treatment. The chemical orier treatment refers to an operation to form the oriented layer in the form of a thin film on the substrate surface; physical orientation treatment refers to an operation to deform the fine shape of the substrate surface. The I crystal molecules are oriented parallel, perpendicularly or diagonally to the substrate by an orienting materia orienting method or the nature of the liquid crystal. The liquid crystal is crosslinked after the orientation. UV are usually used for the crosslinking and the irradiation of the liquid crystal with electron beams or radiations as alpha rays is equally well. The liquid crystal film of a desired shape is formed to the desired position on the substrate in this way.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-74924

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)3月14日

G 02 F 1/1337

1/13

5 2 0 5 0 0

8806-2H 8910-2H

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

②発明の名称

液晶の加工法

昭63-228125 @特 願

昭63(1988) 9月12日 22出 願

明 個発 者 野

博 中 京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1

三洋化成工業

株式会社内

勿出 顧 三洋化成工業株式会社 京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1

明 和 曹

- 1. 発明の名称
 - 液晶の加工法
- 2. 特許勘求の範囲
- 化学的配向処理または物理的配向処理した基 体に保持、配向された液晶を、架構することを特 徴とする液晶の加工法。
- 磁場配向した液晶を架構することを特徴とす る被晶の加工法。
- 3. 液晶が強誘低性液晶である調求項1または2に 記載の加工法。
- 液晶が非級形光学応答を示す調求項1から3の いずれかに記破の液晶の加工法。
- 液晶の 重量 平均分子量が1,000ないし10,000で ある額沢項しからものいずれかに記載の加工法。
- 6. 架橋が光架橋である翻水項1から5のいずれか に記載の加工法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、被晶の加工法に関する。

[従来の技術]

近年、エレクトロニクス応用分野で幅広く使用 されている低分子被晶化合物に対し、高分子被晶 化合物の記録表示素子への用途明発が活発になさ れるようになってきた。 高分子放晶を配向する方 法としてラビングなど低分子液晶化合物の場合と 同様の配向法が試されている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、一般に分子量が数万から数十万 以上で充分な造験性のある高分子被晶を使って配 向しようとしても、 高分子本来の性質である高粘 性のため充分均一な配向膜を得ることが困難であ

[問題点を解決するための手段]

本発明者らは、モノドメインの造膜性液晶配向 膜が得られる加工法について鋭意検討した結果、 本発明に到遠した。

すなわち、木発明は化学的配向処理または物理 的配向処理した基体に保持、 配向された被晶を、

架橋することを特徴とする故品の加工法、 および 磁場配向した被晶を架橋することを特徴とする液 品の加工法である。

本発明において、配向させる被晶としては、(1)架構性液晶化合物、(2)非架構性液晶化合物および架構性非液晶化合物の混合物、ならびに(3)架構性液晶化合物および架構性非液晶化合物の混合物が挙げられる。

架橋性被晶化合物としては、 従来知られている 被晶化合物に架橋性基を化学的に付加、 もしくは 置換した化合物が挙げられる。

そのような液晶化合物としては、フェニル安息香酸エステル類、ピフェニル系およびそのエステル類、フェニルシクロヘキサン系およびそのエステル類、シクロヘキシルシクロヘキサン系およびそのエステル類、フェニルピリミジン系およびそのエステル類等を挙げることができる。

また、分子量の大きな高分子液晶化合物を用いることともできる。 その場合の分子数は、 重量平

[-(CH2) 11-0-Q-COO-Q-COO-] (1)

その他の主鎖型高分子被晶化合物としてはポリ(ァーベンジルグルタメート)などのポリペプチド、 ヒドロキンプロピルセルロース等のセルロース誘 導体を使用することもできる。

側鎖型高分子被晶化合物とは、メソゲンが側鎖にふくまれるもので、スペーサが主鎖とメソゲンとの間に介在してもよい。メソゲンとしては上記に述べた以外に、コレステリル基またはカイラルネマチック基を含むものが挙げられる。側鎖型高分子液晶化合物に用いられる主鎖としては、CーC結合、SI-O結合等が挙げられる。前者の例としては、マクロモレキュラーレ・へミー179第2561頁(1978年)記載の下記化学構造で示される物が挙げられる。

均分子量として通常1,000ないし10,000である。 高分子液晶化合物としては、主鎖型高分子液晶

高分子被晶化合物としては、主鎖型高分子液晶化合物、側鎖型高分子液晶化合物が挙げられる。

主鎖型高分子液晶化合物はメソゲンが主鎖中に含まれる高分子化合物で、必要に応じて可換性のある症(以下スペーサという)を含んでいてもよい。

メソゲンとしては、 \bigcirc -X \bigcirc として表されるものが挙げられる。ここでXとしては、 C H = C H, C - C, C H = C H - C O - O , C O - O , C O - O H, C H = N, N = N, O , O

等が挙げられる。

スペーサとしては、 C 1~ C 12のメチレン領、 オキシエチレン鎖、 オキシプロピレン鎖、 ジメチルシロキサン鎖等が挙げられる。

主鎖型高分子被品化合物の例としては、マクロモレキュラーレ・へくー184巻253頁(1983年)記載の下記構造のものをあげることができる。

後者の例としては、特別昭56-79173号公報記載の 下記化学構造で表されるものが挙げられる。

Ch=コレステリル悲

また本発明において被品として強誘電性液晶であってもよく、 そのようなものとしては、 カイラルアルキル基を含む低分子化合物、 具体的には阿野光治・小林駿介共綱「液晶・基礎績」 7章(培風館、 昭和60年刊行)に記破のものを用いることができる。 またキラルアルキル基を含むトラン類(たとえば特願昭61-43696号報明細番)も使用可能である。 さらには、 下式のような強誘電性の高分子被晶化合物を用いることも可能である。

液晶化合物に付加もしくは置換している架構性 悲としては、光照射が引金になる反応、即ち光架 橋を起こす悲とそれ以外の茲(光架橋以外の反応 により架標する珠)とに大別できる。

光架橋反応を起こす基としては、 ラジカル重合 基、 光二量化する態、 アジド基および カチオン重 合基をあげる事ができる。

ラジカル重合基としては、 アクリレート基、 α-クロルアクリレート基、 メタクリレート基、 スチリル基、 ビニル基、 ビニルケトン基およびアクリルアミド基を挙げることができる。

できる。

架橋性単無体としては(1)2個の重合性二重結合を有する化合物および(2)少なくとも1個の重合性二重結合を有しかつ単量体と反応性の官能基を少なくとも1個有する化合物が挙げられる。

化合物(1)の例としては①ビス(メタ)アクリルアミド②ポリオール類と不飽和モノまたはポリカルボミルのジまたはポリエステル③カルバミルエステル④ジまたはポリビニル化合物⑤ポリオール類のジーまたはポリー(メタ)アリルエーテル⑤ポリカルボン酸のジーまたはポリーアリルエステルの不飽和モノーまたはポリーカルボン酸とポリオールのモノ(メタ)アリルエーテルとのエステル⑥アリロキンアルカン類が挙げられる。

化合物 (2) の例としては (メタ) アクリル酸および/またはその他の共孤合性単微体と反応性の 話たとえばカルボキシル茲、 カルボン酸 無水物茲と反応性の茲 (ヒドロキシル茲、エポキシ茲、 カチォン性茲など) を含むエチレン性不飽和化合物 があげられる。

このようなラジカル 近合抵を含む高分子被晶化合物の例としては、 モレキュラー・クリスタルズ & リキッド・クリスタルズ; レターズ102巻255頁 (1384年)記載のヒドロキシブロビルセルロースのアクリル酸エステルおよび特願昭 62-234657号明細書に記載のアクリル 恋を含むポリシロキサンを挙げることができる。

その他の光架橋反応を起こす悲およびそれ以外の反応により架橋を起こす悲の例としては、特願昭 62-294 657号明細啓に記破のものを挙げることができる。

架橋可能な基で好ましいものは、 光架橋する基であり、 特に好ましいものは、 アクリレート基およびメタクリレート基である。

非架橋性被品化合物としては、 従来から実用に 供されている前述の被晶化合物、 および公知の高 分子被晶化合物を挙げることができる。

本発明において架橋性非被晶化合物としては、架橋性単量体および光硬化性樹脂として実用に供されている種々の高分子化合物をもちいることが

架橋性単位体のうちで好ましいものは、ビス
(メタ) アクリルアミド、ポリオール類と不飽和
モノカルポン酸とのジ‐またはポリ‐エステルおよ
びアリロキシアルカンであり、とくに好ましいも
のはN,N′‐メチレンビスアクリルアミド、エチレ
ングリコールジアクリレート、トリメチロールプ
ロバントリアクリレートおよびテトラアリロキシ
エタンである。 架稿前の含量に限品に対1で返答0∞01~20要量%だあ2。

本発明において、 液晶がとる中間相としては、 スメクチック相(スメクチック A 相、 カイラルス メティック C 相など)ネマチック相 コレステリ ック相などがあげられ、 短い 応答時間が必要な場合は、カイラルスメクチック C 相が好ましい。

本発明において、液晶が液晶相から等方性液体 に転移する温度即ち透明点は、通常0℃以上である が、好ましくは50℃以上である。

架橋可能な 越は、 高分子被晶化合物、 非液晶性 高分子化合物の 主鎖、 側鎖の何れに含まれていて もよい。

本発明において、 液晶は非級形光学応答を示し

非線形光学応答を示す越としては、応用物理57 20174頁(1988年)記版の非線形光学有機物質の残基 を挙げることが出来る。このような基を含む光架 低性高分子液晶化合物の例としては、下記一般式 で表される構造単位を有する共血合体が挙げられる。

液晶には、 放晶性を妨げない 限りに於て、 必要に応じて、 以下に述べるような 型々の 助剤を予め 加えておくことができる。

光架橋を起こすための光開始剤としては、光・放射線硬化技術」(大成社、昭和60年)12頁に記載の化合物、例えばアセトフェノン、ペンソフェ

錯体、ナフトキノン類などが挙げられる。

また被晶には、 応答時間短縮または駆動しきい 電圧低下のために非被晶性 被体を含有させることができる。 このようなものとしては、 2-オキサゾリジノン類、 プロピレンカーポネート、 ジアルキルビスフェノール類、 アルキルシクロヘキシルシクロヘキサン類などが挙げられる。

本発明において、 液晶の処方例は次の通りである。 %は重量%である。

	通常	好ましくは
架橋性液晶化合物(1)	:0~100%	50~99%
非 架 橋 性 被 晶 化 合 物(工)	0~70	0~70
架橋性非液晶化合物	0~50	0~30
光明始剤	0~10	0~2
二色性色素	0~10	0~5
記録光吸収色絮	0~20	1~10
非液晶性液体	0~20	0~10

但に(エ)と(工)の合言に風常30~10%, 好ましくは50.99%である。 本発明において、被晶は基体上に保持される。 ノン、 ミヒラーケトン、 ベンジル、 ベンゾイン、 ベンゾインエーテル、 ベンジルエーテル、 ベンジ ルジメチルケタール、 チオキサントン及びそれら の誘導体を挙げることができる。

被温には液晶の記録を表示或は読み出すうえで必要上、二色性色素を含有させることも可能である。二色性色素としては、メロシアニン色素、アントラキノン色素、アソ色素、スチリル色素、アンメチン色素およびスクワリリウム色素を挙げることができる。

被温には光吸収色素を含有させることができ、 記録光の放長に合わせて選ぶことができる。 半導 体レーザ用いる場合は、 近赤外線吸収色素をもち いるのが好ましく、 He-Neレーザ、 Arレーザ、 タン グステンランブ、 ハロゲンランブ 等を用いる場合 は可視光吸収色素を用いるのが好ましい。

近赤外線吸収色素は近年種々のものが開発されており、有機合成化学43巻4号36~45頁(1985年)に記載のもの、たとえばフタロシアニン類、テトラアヒドロコリン、ベンゼンジチオールニッケル

基体としては、使用目的に応じて、熱伝導性、機械的強度、光学的性質、平面精度、などを考慮して選択する。具体的には、ガラス、セラミックス、ブラスチックス、(アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリカーポネート樹脂、ポリオレフィン樹脂)、金属(アルミニウムなど)の一般に使用されている基体があげられる。

基体の形状は、 川途に応じ歴々変えることができ 例えば、 板状、 ディスク (円盤) 状、 ドラム状等 か挙げられる。

基体に保持する場合に、 造膜性 放品と 基体 との 密 管性をよくするために、 粘 着 剤、 接 登 剤 等 を 用いてもよい。 このようなものとしては、 ラミネートフィルム 用に 通常 用いられているような 粘 登 剤、及び接 箸 剤を 用いることが 可能である。

本発明において、 被品は配向処理を施した恐体に保持して配向する。

本発明に於て、 化学的配向処理とは基体表面に 薄層状に配向層を形成する操作であり、 液晶を主 としてファン・デア・ワールス力、 双極子間相互 作用、水瓷結合力で配向制御するものである。

化学的配向処理法として、(1)配向剤溶液の塗布 (化学結合あるいは吸管による配向層の形成)、(2)配向剤の水面展開(ラングミュア・プロジェット 法)(3)プラズマ重合に大別できる。

本発明において物理的配向処理とは、 基体製面の数細な形状を変形する操作である。

物理的配向処理法として、(1)ラビング法(2)茲 . 着法に大別できる。

配向剤、配向法によって、或は放晶の性質によって、液晶分子は基体に対し並行、垂直或は斜めに配向する。

具体的な配向剤、配向処理法については、「被晶の最新技術」53頁(工業調査会、1983年刊)に記載のものを挙げることができる。

本発明において、配向は磁場を用いて行ってもよい。

この場合の磁場の強さは、 通常、 5~20kGで、 一定方向の磁場でも交番する磁場でもいずれでもよい。

を真空蒸發して設ける。

反射防止層は、 薄腹ハンドブック 820頁(昭和58年、 オーム社)に記載の透明無機化合物、 例えば、 フッ化マグネシウムを蒸着などの手段を行い 設置することができる。

本発明の加工法にしたがって得られる被晶は、記録表示素子として用いることができる。

素子は、光を用いて記録することができる。記録光としては、半導体レーザ、 Arレーザ、 Be-Neレーザなどの記録光が用いられる。

レーザ光の照射法としては、一般に1~10μaφ に絞ったビームをパルス幅0.1~10μsで、エネル ギー5~20mlで照射する方法が挙げられる。

本発明において、配向後、液晶は深橋する。 架橋は光を用いて行うのが好ましい。 この光としては、 通常、 紫外線が用いられるが、 電子線や、 α線などの放射線を照射させてもよい。

本発明において、 光照射の際、 光源とのあいだにフォトマスクを介在させ、 目的のパターンを形成しても良い。 この様な場合には、 適当な現像液、 例えば、 メチルエチルケトン、 キシレンなどの育機溶媒で、 現像、 洗浄、 乾燥する。 こうして、 基体上の所望の位置に所望の形状の液品膜を形成することが出来る。

このように基体上に形成された液品膜からなる 記録表示層に加えて、記録表示の目的で値々の 機能をもつ層を設けることができる。 このようなものとしては、光吸収層、反射層、反射防止層、 保設層などを挙げることができる。

光吸収層は、前述の光吸収色素を塗布などによって使用することもできるが、カーボン、 金瓜 (ビスマス、テルルなど)を真空誘導によって成膜してもよい。 反射層は通常、アルミニウム、銀等

いることもできる。

また記録に光でなく、熱源、たとえばサーマルブリンタヘッドなどをもちいることもできる。

読み出しは、一般に光学ヘッドを用いて行われる。

また、本発明の加工法にしたがってえられる液 品は、大面積の表示設置として用いることが出来、 この場合、、必要により背面から、 バックライト による照明を行うこともできる。

梢去は、熱または光によっておこなうことができる。熱による場合は、亦外線ランプ、ニクロム線ヒーク等で、通常100~150℃に記録圏を加熱する。光によって梢去するばあいにおいては、記録に用いたのと同じレーザ光を使用することができる。

記録・消去は、 繰り返し、 例えば、 10~100回以 上行うことができる。

[寒施例]

以下、実施例によか木発明を更に説明するが、 本発明はこれに限定されるものではない。

寒 施 例 1

光架橋性の被品化合物を合成するため、まず4-アリロキン安息香酸トリチルエステルを、塩化トリチルおよび4-アリロキシ安息香酸をTIIF(テトラヒドロフラン)ートリエチルアミン中で反応させて得た。このトリチルエステル0.84g、4-アリロキシ安息香酸-4'-シアノフェニルトリエステル(CNS0-3)2.23gおよび1,3,5,7-テトラメチルテトラシロキサン0.8gから得られる中間体に水/酢酸を作用させて、トリチル茲を除去した。次に、無水トリフルオロ酢酸、アクリル酸ヒドロキシエチルを順次反応させることによりアクリレート基をメソゲン基に対して約20モル%含有する光架橋性高分子液晶化合物を得た。

光閉始剤イルガキュア184(チバガイギー社製)を0.5%加えた混合物を、予めポリイミド塗布、ラビング処理した2枚のガラス板に、 被晶の膜厚が10μmになるようはさみ、 80℃に加熱した後徐冷すると均一に配向した。 次にこの膜に、 紫外線照射装置(ウシオユーテック(株)製)を用いて紫外線

錫ジラウレート50mgをコルベンに投入し、75 ~85℃で4時間反応させたのち、2-ヒドロキシェチルアクリレート348gおよびハイドロキノンモノメチルエーテル0.1gを仕込んで、さらに20時間反応させてアクリロイル茲を1分子中3個有するオリゴマーをえた。

前記の強誘電性被晶化合物7.0g, オリゴマー0.7g およびペンゾインメチルエーテル0.1gを均一混合したのち、実施例1と同様にガラス基板に挟み50度に加熱したのち徐冷した。次に紫外線を照射し架構して、全体に均一な配向膜を得た。 [発明の効果]

本発明の液晶の加工法は次のような効果を奏する。

(1) 本発明の方法では、分子量が1、000から10、000程度の液晶を配向しておき高分子量化するため、均一配向を妨げていた高分子本来の性質である高粘性の問題点を回避出来る。

従来のような分子量が数万から数十万以上で充分な力学的強度のある高分子液晶は配向が困難であ

(1.0J/cm²) を照射した。 こうしてえられた架橋 高分子被晶化合物の膜は、全体が均一な配向度の 高い膜であった。

奥 施 例 2

N,N-ジメチル・N-オクタデシル-3-アミノブロビルトリメトキシシリルクロライド (DMOAP、 ダウコーニング「XZ-2-2300」) を塗布した2枚のガラス基板に、実施例1と同一の液晶を挟み、垂直配向させた。これに紫外線を照射し、全体が均一な配向した高分子液晶化合物の架構態をえた。

実施例3

被品討論会予額集150頁(1987年)記載の方法に従い、光学活性2-メチルブクノール、 (*) - オキシフェニール - 4 - 安息香酸、1、12-ジブロムドデカンおよびアクリル酸を出発原料として光学活性な強誘電性液晶化合物を合成した。 一方、 サンニックスポリオール GP-300 (グリセリンにプロピレンオキンドを平均3.6モル付加させたもの、 三洋化成工業 (株) 製) 300g, イソホロンジイソシアネート625g,シクロヘキサノン300gおよびジブチル

った。

(2) 比較的低濃度の架構性落で高分子量化が起こるため、膜に処裂が発生しにくい。

従来から知られているようなモノアクリレート 系被晶化合物のような頂合性基をもつ低分子液晶 化合物を配向後重合すると登しく収縮し亀裂が生 にる。

(3) 架機することによりメソゲンが配向した状態で主領を固定でき、 力学的強度の優れた配向膜が得られる。

上記効果を有することから、 本発明の加工法を 用いると、 記録表示案子に応用することが可能に なる。

特許出願人

三洋化成工業株式会

